



## 【1000～2000万円】 Power Device Design Senior Engineer

外資系デバイスメーカーでの募集です。電子デバイス研究開発のご経験のある方は歓迎...

### 募集職種

#### 人材紹介会社

株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント

#### 採用企業名

外資系デバイスメーカー

#### 求人ID

1487788

#### 業種

通信・キャリア

#### 会社の種類

外資系企業

#### 雇用形態

正社員

#### 勤務地

大阪府

#### 給与

1000万円～2000万円

#### 勤務時間

09:00～18:00

#### 休日・休暇

【有給休暇】有給休暇は入社後4ヶ月目から付与されます 初年度 14日 4か月目から 【休日】完全週休二日制 土日 夏季休暇 ...

#### 更新日

2025年01月31日 13:01

### 応募必要条件

#### キャリアレベル

中途経験者レベル

#### 英語レベル

ビジネス会話レベル

#### 日本語レベル

ネイティブ

#### 最終学歴

大学卒：学士号

#### 現在のビザ

日本での就労許可が必要です

### 募集要項

#### 【求人No NJB2224778】

・高性能パワーデバイス（SiC MOSFET/SBD、GaN HEMT、Si IGBT）のデザイン開発とテスト検証を担当し、プロセスチームと協力してデバイス加工とプロセスの最適化を行う。  
・高性能パワーデバイス（SiC MOSFET/SBD、GaN HEMT、Si IGBT）の個別技術をフォローアップし、既存のデバイスの性能を向上させ、パテントポートフォリオを提案して実現させる。

---

## スキル・資格

### 必須要件

- ・半導体/電子/物理などの関連分野を専攻し、5年以上のパワーデバイスのデザイン開発経験（直近の3年間には関連のデザイン開発の従事が必須）、または優秀な博士課程の新卒者。
- ・パワーデバイス（SiC MOSFET/SBD、GaN HEMT、Si IGBT）の基本構造とデバイスシミュレーションデザイン方法に精通し、TCADソフトやレイアウトソフトを使用しデバイスデザインが得意な方。
- ・良好なコミュニケーション能力があり、異なる地域や異なる文化背景のチームと良好なコミュニケーションがとれる方。

---

## 会社説明

ご紹介時にご案内いたします